

2SC1974

# 2SC1974 (暂定/PRELIMINARY)

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ型/Si NPN Epitaxial Planar

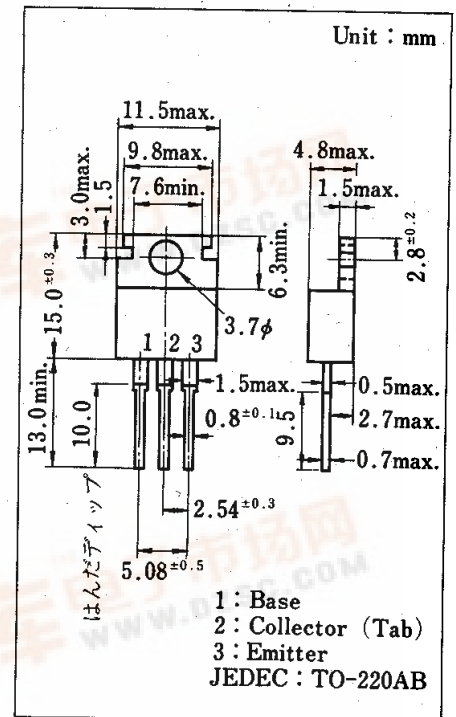
トランシーバー送信出力用/Transceiver Power Output

### 特徴/Features

- 高利得/High gain
- 出力 5 W/P<sub>o</sub>=5 W (min.)
- 破壊強度が大きい/Withstands worst overload conditions.

### 最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V <sub>CBO</sub>	80	V
コレクタ・エミッタ電圧 (R <sub>BE</sub> =100Ω)	V <sub>CER</sub>	80	V
エミッタ・ベース電圧	V <sub>EBO</sub>	4	V
せん頭コレクタ電流	I <sub>CM</sub>	3	A
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	2	A
コレクタ損失 (Tc=25°C)	P <sub>C</sub>	12	W
接合部温度	T <sub>j</sub>	150	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55~+150	°C



### 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース電圧	V <sub>CBO</sub>	I <sub>C</sub> =1mA, I <sub>E</sub> =0	80			V
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CER</sub>	I <sub>C</sub> =2mA, R <sub>BE</sub> =100Ω	80			V
エミッタ・ベース電圧	V <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> =10μA, I <sub>C</sub> =0	4			V
コレクタシャ断電流	I <sub>CEO</sub>	V <sub>CE</sub> =40V, I <sub>B</sub> =0			1	μA
直流電流増幅率	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =1A	30	60	150	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =2A, I <sub>B</sub> =0.2A		0.6	1	V
トランジション周波数	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =500mA		150		MHz
コレクタ出力容量	C <sub>ob</sub>	V <sub>CB</sub> =10V, I <sub>E</sub> =0, f=1MHz		40		pF
出力電力	P <sub>o</sub>	V <sub>CC</sub> =13.5V, f=27MHz, P <sub>in</sub> =0.2W	4.5			W

